

■MOCVD 装置主要性能

型 式		SV2001/SV3001/SV4001 (SV2003)	SH2001/SH3001/SH4001 (SH2003)
リアクタ形状		縦型石英リアクタ	横型ステンレスリアクタ
基板(ウエハ)サイズ×枚数		φ2"×1、φ3"×1、φ4"×1(φ2"×3)	φ2"×1、φ3"×1、φ4"×1(φ2"×3)
ウエハ面		フェイスアップ	フェイスアップ
加熱方式		抵抗加熱方式	抵抗加熱方式
基板回転機構		0~30rpm	0~30rpm
基板加熱温度(制御用熱電対値)		900℃	1300℃
プロセス排気		ロータリーポンプ(ドライポンプはオプション対応)	ロータリーポンプ(ドライポンプはオプション対応)
投入室	排気システム	ターボ分子ポンプ+ロータリーポンプ ※ドライポンプはオプション対応	ターボ分子ポンプ+ロータリーポンプ ※ドライポンプはオプション対応
	基板保管機構(3枚ストック)	標準装備	標準装備
搬送機構		トランスファーロード式またはレール式	トランスファーロード式またはレール式
ガス制御ボックス(標準) ※系統数は、お客様のご要望に応じます。		有機金属 6 系統	有機金属 6 系統
		水素化物系 3 系統	水素化物系 3 系統
		キャリアガス 2 系統	キャリアガス 2 系統
		ベントガス 2 系統	ベントガス 2 系統
		ダミーライン	ダミーライン
シリンダーキャビネット ※系統数は、お客様のご要望に応じます。		パージライン	パージライン
		47L(10L)容器 4 本立(ガス 3 本、窒素 1 本)	47L(10L)容器 4 本立(ガス 3 本、窒素 1 本)
制御装置	操作パネル	標準装備	標準装備
	異常表示	標準装備	標準装備
	インターロック機能	標準装備	標準装備
	自動成長システム	標準装備	標準装備
	バックアップ電源	標準装備	標準装備
	保安装置 (ガス漏洩、地震、各種異常の検知、警報およびインターロック)	標準装備	標準装備
その他	窒素精製器	オプション	オプション
	水素精製器	オプション	オプション
	除害装置	オプション	オプション
	In-Situ モニタリングシステム	オプション	オプション